

2006年3月1日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第145委員会  
委員長 梅野 正隆

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会  
第106回研究会・委員総会開催通知

日時：2006年3月9日(木) 13:00 ~ 17:30

会場：弘済会館 4階 さくらの間

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-1、TEL: 03-5276-0333

JR 四ツ谷駅または地下鉄丸の内線四ツ谷駅下車徒歩5分、有楽町線麹町駅下車徒歩2分

テーマ：「SiC半導体結晶の成長と評価の最前線」

世話人：田島 道夫 (JAXA 宇宙研) 木本 恒暢 (京都大学大学院工学研究科)

プログラム：

13:00-13:30

(1)「SiC半導体結晶・デバイスの展望(仮)」 松波 弘之 (JST 研究成果活用プラザ京都)

13:30-14:00

(2)「SiCバルク結晶成長における転位低減(仮)」 中村 大輔 (豊田中央研究所)

14:00-14:30

(3)「高品質半絶縁性SiC基板の作製(仮)」 塩見 弘 (シクスオン)

14:30-15:00

(4)「SiCエピ成長における転位の挙動と欠陥評価(仮)」 土田 秀一 (電力中央研究所)

15:00-15:15 休憩

15:15-15:45

(5)「SiC(000-1)面上の高品質SiCエピタキシャル成長(仮)」  
児島 一聡 (産業技術総合研究所)

15:45-16:15

(6)「PLマッピングによるSiCウェーハの欠陥評価(仮)」 田島 道夫 (JAXA 宇宙研)

16:15-16:45

(7)「極紫外ラマン散乱によるSiC結晶表面層の評価」  
中島 信一、三谷 武志 (産業技術総合研究所)

16:45-17:15

(8)「Development of SiC Power Devices(仮)」  
Peter Friedrichs (SiCED, Germany)

17:15 委員総会

以上